

HEC/MA/P10

10 JUN 2005

PCT/NL

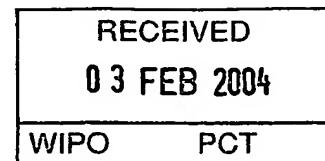
0 3 / 0 0 8 8 6

KONINKRIJK DER



NEDERLANDEN

Bureau voor de Industriële Eigendom



Hierbij wordt verklaard, dat in Nederland op 12 december 2002 onder nummer 1022155,  
ten name van:

**OTB GROUP B.V.**

te Eindhoven

een aanvraag om octrooi werd ingediend voor:

"Werkwijze, alsmede inrichting voor het behandelen van een oppervlak van ten minste één  
substraat",

en dat de hieraan gehechte stukken overeenstemmen met de oorspronkelijk ingediende stukken.

Rijswijk, 9 januari 2004

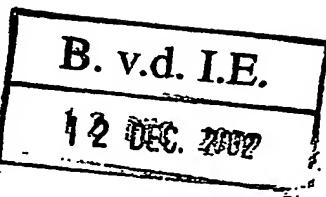
De Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom,  
voor deze,

A handwritten signature in black ink.

Mw. M.M. Enhus

**PRIORITY DOCUMENT**  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

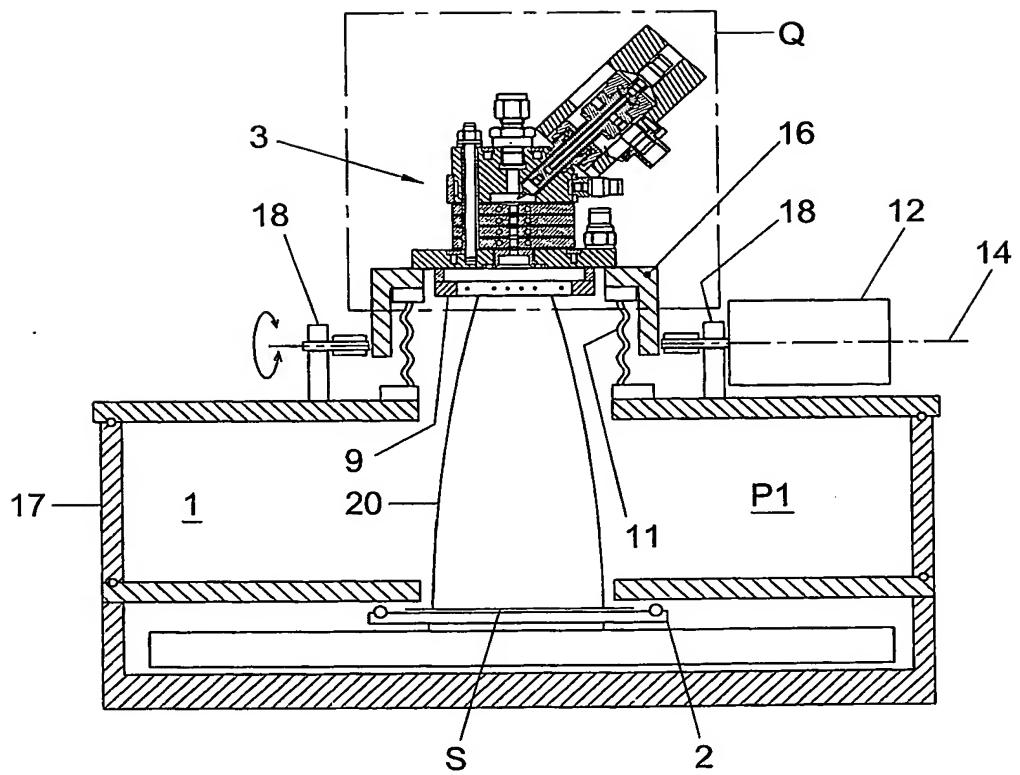
1022159



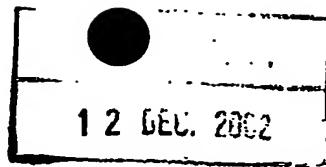
### UITTREKSEL

Werkwijze voor het behandelen van een oppervlak van ten minste één substraat (S), waarbij het ten minste ene substraat (S) in een proceskamer wordt geplaatst, waarbij de druk (P1) in de proceskamer relatief laag is, waarbij een plasma wordt opgewekt door ten minste één op de proceskamer gemonteerde plasmabron, waarbij een deel van het plasma contact maakt met het substraatoppervlak, waarbij de ten minste ene plasmabron (3) tijdens de behandeling wordt bewogen ten opzichte van het substraatoppervlak. De uitvinding verschaft verder een inrichting voor het behandelen van een oppervlak van ten minste één substraat (S), waarbij de inrichting is voorzien van een proceskamer en ten minste één op die proceskamer gemonteerde plasmabron, waarbij de ten minste ene plasmabron (3) beweegbaar is opgesteld. Voorts verschaft de uitvinding een substraat, voorzien van een oppervlak met ten minste één daarop door middel van PECVD gedeponeerde laag materiaal.

1022155



1022155



P56650NL00

**Titel: Werkwijze, alsmede inrichting voor het behandelen van een oppervlak van ten minste één substraat.**

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het behandelen van een oppervlak van ten minste één substraat, waarbij het ten minste ene substraat in een proceskamer wordt geplaatst, waarbij de druk in de proceskamer relatief laag is, waarbij een plasma wordt opgewekt door een op de proceskamer gemonteerde plasmabron, waarbij een deel van het plasma contact maakt met het substraatoppervlak.

5 Deze werkwijze is bekend uit het Europese octrooi EP-0-295-752.

Aangezien de plasmabron op de proceskamer is gemonteerd wordt het plasma in hoofdzaak buiten de proceskamer gegenereerd. Ten gevolge van  
10 de lage druk in de proceskamer kan een deel van het plasma vanuit de plasmabron naar de proceskamer expanderen via een doorgang tussen genoemde bron en kamer om contact te maken met het substraatoppervlak.

De bekende werkwijze kan voor verschillende doeleinden worden toegepast. Zo kan met deze werkwijze bijvoorbeeld een laag materiaal op het  
15 substraatoppervlak van het ten minste ene substraat worden gedeponeerd, in het bijzonder door middel van Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition (PECVD). In dat geval wordt doorgaans een mengsel van behandelgassen in het plasma gevoerd om tot reactieve fragmenten uiteen te vallen. Deze fragmenten kunnen met elkaar en/of het substraatoppervlak  
20 reageren ten behoeve van depositie van de laag. Verder kan de bekende werkwijze worden gebruikt om juist materiaal van het substraatoppervlak te verwijderen door middel van plasma-etsen, ook wel droog-etsen genoemd. In dat geval heeft de samenstelling van het plasma doorgaans een etsende werking op het substraatoppervlak. De relatief lage druk in de proceskamer  
25 is doorgaans onderatmosferisch, bijvoorbeeld minder dan 5000 Pa, in het bijzonder minder dan 500 Pa.

Voordeel van de bekende werkwijze is, dat het plasma door een op de proceskamer gemonteerde plasmabron wordt opgewekt, hetgeen het verrassende voordeel biedt dat daardoor een relatief hoge behandelsnelheid, zoals een hoge depositiesnelheid bij PECVD, kan worden verkregen. Dit is 5 in tegenstelling tot een conventionele plasmareactor waarbij de plasmabron zich juist in de proceskamer bevindt en het te behandelen substraat tussen elektroden van de plasmabron wordt geplaatst, hetgeen tot een ongewenst lage behandelsnelheid leidt.

Nadeel van de werkwijze volgens de aanhef is, dat controle over de 10 uniformiteit van de behandeling te wensen over laat. Daardoor kunnen delen van het substraatoppervlak bijvoorbeeld te veel of te weinig behandeling ondergaan, zodat daarop in het geval van PECVD resp. plasma-etsen een ongewenst dikke of dunne laag materiaal wordt gedeponeerd resp. weggenomen ten opzichte van andere delen van het 15 substraatoppervlak.

De uitvinding beoogt de genoemde nadelen van de in de aanhef genoemde werkwijze op te heffen, in het bijzonder een werkwijze waarmee de uniformiteit van de behandeling zeer goed kan worden beheerst.

Hiertoe wordt de werkwijze volgens de uitvinding gekenmerkt, 20 doordat althans één plasmabron en/of althans één eventueel voorziene behandelfluidumtoevoerbron tijdens de behandeling wordt bewogen ten opzichte van het substraatoppervlak.

Op deze manier kan de behandeling en met name de uniformiteit daarvan zeer nauwkeurig worden beheerst. Door de beweging kan de 25 hoeveelheid plasma die een deel van het substraatoppervlak bereikt, naar wens worden aangepast. Zo kan de ten minste ene plasmabron en/of behandelfluidumtoevoerbron zodanig worden bewogen, dat elk deel van het substraatoppervlak in hoofdzaak dezelfde mate van behandeling ondergaat, in het bijzonder doordat elk deel van dat oppervlak door dezelfde 30 hoeveelheid plasma wordt bereikt. Op deze manier kan bijvoorbeeld een

zeer goede uniformiteit van de behandeling worden verkregen, zodat een laag materiaal zeer uniform op het substraatoppervlak kan worden gedeponeerd door PECVD of daarvan worden geëtst door droogetsen met het plasma. Anderzijds kan het gewenst zijn om juist een niet-uniforme  
5 behandeling te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer een deel van het substraatoppervlak beduidend meer of minder materiaal dient te verkrijgen of verliezen. In dat geval kan de plasmabron en/of de behandelfluïdumtoevoerbron zodanig ten opzichte van het oppervlak worden bewogen, dat ten minste een eerste deel van het substraatoppervlak in  
10 hoofdzaak een grotere mate van behandeling ondergaat dan een tweede deel van dat oppervlak, in het bijzonder doordat het eerste oppervlakdeel door een grotere hoeveelheid plasma wordt bereikt dan het tweede oppervlakdeel.

De plasmabron en/of de behandelfluïdumtoevoerbron kan op  
15 verscheidene manieren worden bewogen. Zo kan de plasmabron en/of de behandelfluïdumtoevoerbron om ten minste één rotatieas geroteerd, welke as zich in hoofdzaak evenwijdig aan het substraatoppervlak uitstrekt. Verder kan de plasmabron en/of de behandelfluïdumtoevoerbron in een naar het substraatoppervlak toe of daarvan afgekeerde richting worden bewogen.  
20 De plasmabron en/of de behandelfluïdumtoevoerbron kan bovendien in ten minste één zijwaartse richting wordt bewogen ten opzichte van het substraatoppervlak. Voorts kan de plasmabron en/of behandelfluïdumtoevoerbron worden geroteerd om een as die zich haaks uitstrekt ten opzichte van het substraatoppervlak. Een dergelijke beweging  
25 ressorteert met name effect wanneer de bron geen rotatiesymmetrisch plasma genereert. Elke plasmabron kan een combinatie van deze bewegingen uitvoeren. Wanneer de werkwijze onder gebruikmaking van verscheidene plasmabronnen wordt uitgevoerd, kan een aantal of elk van deze bronnen bijvoorbeeld ten minste één van de genoemde manieren van  
30 beweging uitvoeren.

In het geval een behandelfluïdum aan het plasma wordt toegevoegd, in het bijzonder ten behoeve van PECVD, is het voordelig wanneer de hoeveelheid aan het plasma toe te voegen behandelfluïdum is gerelateerd aan de beweging van de ten minste ene plasmabron.

5        Zo kan het effect van de beweging van de tenminste ene plasmabron bijvoorbeeld worden versterkt of verzwakt door meer of minder behandelfluïdum aan het plasma toe te voegen vóór, gedurende en/of na die beweging. Verder kan op deze manier de hoeveelheid behandelfluïdum nauwkeurig worden afgestemd op bewegingen van de plasmabron om  
10      behandeling van het substraatoppervlak zeer precies onder controle te houden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat plasma vanuit de plasmabron een kleinere afstand naar het substraatoppervlak hoeft af te leggen wanneer de bron zich in een eerste stand bevindt ten opzichte van de afstand wanneer de bron zich na een bepaalde beweging in een tweede stand bevindt.

15      Daardoor is het mogelijk dat minder plasma het substraatoppervlak bereikt bij de bron in de tweede stand, hétgeen tot verlies van effectiviteit van een in het plasma opgenomen behandelfluïdum kan leiden. In dat geval kan meer behandelfluïdum aan het plasma worden toegevoegd bij de bron in de tweede stand ter compensatie van het genoemde verlies aan effectiviteit.

20      Volgens een nadere uitwerking van de uitvinding is de ten minste ene plasmabron een cascadebron, waarbij een behandelfluïdum in een voorkamer van de cascadebron, nabij een zich in die voorkamer bevindende cascadebron-kathode, wordt toegevoerd.

25      Op deze manier kan het behandelfluïdum met relatief eenvoudig en goedkoop uit te voeren middelen in de voorkamer aan het plasma worden toegevoerd.

30      Volgens een voordelige uitwerking van de uitvinding is tussen de ten minste ene plasmabron en het substraatoppervlak ten minste één genoemde behandelfluïdumtoevoerbron opgesteld om het behandelfluïdum aan het plasma toe te voegen. In het vakgebied wordt een dergelijk

behandelfluïdumtoevoerbron ook wel een doucheknop (e. showerhead) genoemd.

Met een douchekop kan het behandelfluïdum gemakkelijk en evenredig gedistribueerd aan het plasma worden toegevoegd. Bij voorkeur 5 wordt de ten minste een douchekop tijdens de behandeling bewogen ten opzichte van het substraatoppervlak, waarbij de beweging van de douchekop gerelateerd is aan de beweging van de ten minste een plasmabron zodat de genoemde voordelige effecten van de beweging van de plasmabron optimaal kunnen worden, althans niet door de aanwezigheid van de douchekop teniet 10 worden gedaan. De douchekop kan hiertoe bijvoorbeeld aan de plasmabron zijn gekoppeld.

De uitvinding heeft voorts betrekking op een inrichting voor het behandelen van een oppervlak van ten minste één substraat, waarbij de inrichting is voorzien van een proceskamer en een op die proceskamer 15 gemonteerde plasmabron.

Een dergelijke inrichting is eveneens bekend uit het Europese octrooi EP-0-295-752. Nadeel van deze inrichting is dat deze niet voldoende controle verschaft over de uniformiteit van een met de inrichting uit te voeren behandeling op het substraatoppervlak.

Volgens de onderhavige uitvinding wordt het genoemde nadeel 20 opgeheven doordat de ten minste een plasmabron en/of althans één eventueel voorziene behandelfluïdumtoevoerbron beweegbaar is opgesteld.

Met de beweegbaar opgestelde plasmabron en/of behandelfluïdumtoevoerbron kunnen verschillende delen van het 25 substraatoppervlak door daardoor gegenereerd plasma worden bereikt ter behandeling van dat oppervlak, hetgeen een zeer hoge mate van controle over de uit te voeren behandeling schept.

De uitvinding verschaft verder een substraat voorzien van een oppervlak met ten minste één daarop door middel van PECVD 30 gedeponeerde laag materiaal, gekenmerkt doordat de laag is gedeponeerd

met een werkwijze volgens één van de conclusies 1-12 en/of onder  
gebruikmaking van een inrichting volgens één van de conclusies 13-25.

De laag van dit substraat is op een met het oog op een bepaalde  
gewenste uniformiteit zeer goed gecontroleerde wijze op het  
5 substraatoppervlak gedeponeerd. Derhalve zijn de eigenschappen van deze  
laag uniek ten opzichte van lagen van substraten die volgens conventionele  
PECVD technieken zijn gedeponeerd. De laag kan bijvoorbeeld zeer  
uniforme dikte hebben of juist een dikte die op een bepaalde manier  
varieert.

10 De uitvinding zal nader worden toegelicht aan de hand van een  
uitvoeringsvoorbeeld en de tekening. Daarin toont:

fig. 1 een bovenaanzicht van een uitvoeringsvoorbeeld;  
fig. 2 een doorsnede-aanzicht over lijn II-II van het in fig. 1  
weergegeven bovenaanzicht; en

15 fig. 3 detail Q van het in fig. 2 weergegeven doorsnede-aanzicht.

De figuren 1-3 tonen een inrichting voor het behandelen van een  
oppervlak van een substraat S. De inrichting is voorzien van een  
proceskamer 1 en een daarbij opgestelde substraathouder 2 waarop het te  
behandelen substraat S is geplaatst. Op de proceskamer 1 en tegenover het  
20 te behandelen substraatoppervlak is een plasmabron 3 gemonteerd.

Zoals fig. 3 toont is de plasmabron een cascadebron 3. De bron 3 is  
voorzien van een kathode 4 die zich in een voorkamer 6 bevindt en een  
anode 5 die zich aan een naar de proceskamer 1 toegekeerde zijde van de  
bron 3 bevindt. De voorkamer 6 mondt via een relatief nauw kanaal 7 uit in  
25 de proceskamer 1. Het kanaal 7 wordt begrensd door onderling elektrisch  
van elkaar geïsoleerde cascadeplaten 8 en de genoemde anode 5. Tijdens  
gebruik wordt de proceskamer 1 op een relatief lage druk gehouden, in het  
bijzonder lager dan 5000 Pa, en bij voorkeur lager dan 500 Pa. Tussen de  
kathode 4 en anode 5 wordt een plasma gegenereerd, bijvoorbeeld door  
30 ontsteking van een zich daartussen bevindend edelgas of anderszins

daarvoor geschikt fluïdum. Wanneer het plasma in de bron 3 is gegenereerd is de druk P2 in de voorkamer 6 hoger dan de druk in de proceskamer 1. Eerstgenoemde druk P2 kan bijvoorbeeld in hoofdzaak atmosferisch zijn en liggen in het bereik van 0,5-1,5 bar. Doordat de druk in de proceskamer 1 5 aanzienlijk lager is dan de druk in de voorkamer 6 expandeert een deel 20 van het gegenereerd plasma zodanig, dat het zich via het relatief nauwe kanaal 7 tot in de proceskamer 1 uitstrekt om contact te maken met het substraatoppervlak.

De plasmabron 3 is beweegbaar opgesteld ten opzichte van het 10 substraatoppervlak. Hiertoe is de plasmabron 3 is op een bovenste huisdeel 16 van de inrichting gemonteerd. Het bovenste huisdeel 16 is aan een onderste huisdeel 17 gekoppeld door middel van een flexibele, in hoofdzaak gasdichte afdichting. In het onderhavige uitvoeringsvoorbeeld is de 15 afdichting uitgevoerd als een cilindrisch verend lichaam 11. Het verend lichaam 11 is bovendien ingericht om een zodanige veerkracht op de ten minste ene plasmabron 3 uit te oefenen, althans via het bovenste huisdeel 16, dat de plasmabron 3 onder invloed van die veerkracht telkens naar de in 20 de figuren getoonde uitgangspositie kan bewegen wanneer de plasmabron 3 naar een andere positie is gebracht. In het onderhavige uitvoeringsvoorbeeld wordt het verende lichaam 11 gevormd door een dunwandige RVS-balg.

Ten behoeve van het bewegen van de plasmabron 3 is het bovenste huisdeel 16 om twee verschillende assen 14, 15 roteerbaar aan het onderste huisdeel 17 gekoppeld. Hiertoe is het bovenste huisdeel 16 roteerbaar om 25 een rotatieas 15 verbonden aan een draagring 19, terwijl deze draagring 19 roteerbaar om een rotatieas 14 verbonden is aan steunen 18 die op het onderste huisdeel 17 zijn bevestigd. De inrichting is voorzien van een eerste motor 12 en een tweede motor 13 om het bovenste huisdeel 16 met de bron 3 naar een gewenste positie te bewegen. Aangezien de twee rotatieassen 14 en

15 zich haaks op elkaar uitstrekken kan de plasmabron 3 naar zeer veel verschillende standen worden bewogen.

Zoals figuren 2 en 3 tonen is de proceskamer 1 voorzien van een douchekop 9. De douchekop is ingericht om het behandelfluïdum aan het zich via het relatief nauwe cascadebronkanaal 7 tot in de proceskamer 1 uitstrekende plasma 20 toe te voegen, in het bijzonder voor het uitvoeren 5 van PECVD. De douchekop 9 is voorzien van tenminste één plasmadoorgangen 21 waardoorheen het plasma 20 zich kan uitstrekken. De doucheknop kan bijvoorbeeld een ringvormige leiding omvatten die is 10 voorzien van een aantal uitstroomopeningen 22 waardoorheen het behandelfluïdum in het plasma 20 kan worden gebracht. De douchekop 9 is aan de plasmabron 3 is gekoppeld, althans via het bovenste huisdeel 16, zodat de douchekop 9 bewegingen van de plasmakop 3 kan volgen.

Tijdens gebruik van deze inrichting kan de plasmabron 3 worden 15 bewogen om een zeer goede beheersing van een plasmabehandeling van het substraatoppervlak te verkrijgen. Dit is bijzonder voordelig aangezien daardoor bijvoorbeeld materiaal op het substraat S kan worden gedeponeerd met een zeer uniforme laagdikte. Het bovenste huisdeel met de bron 3 kan bijvoorbeeld zodanig worden bewogen dat delen van het substraatoppervlak 20 welke te weinig plasma ontvangen, bijvoorbeeld nabij de rand van het substraat, een extra hoeveelheid plasma ontvangen om toch voldoende behandeling te ondergaan. Anderzijds kan juist materiaal op zeer uniforme wijze van het substraatoppervlak worden drooggeëetst. Daarnaast kan door beweging van de bron 3 worden bereikt dat bepaalde delen van het 25 substraatoppervlak een aanzienlijk grotere mate van behandeling ondergaan dan andere delen. Zo kan bijvoorbeeld in hoofdzaak een helft van het substraatoppervlak worden behandeld door een rotatie van de bron om een van de twee weergegeven rotatieassen 14, 15 terwijl de andere helft van het oppervlak in hoofdzaak onbehandeld blijft.

Het spreekt vanzelf dat de uitvinding niet beperkt is tot het beschreven uitvoeringsvoorbeeld. Diverse wijzigingen zijn mogelijk binnen het raam van de uitvinding.

Zo dient de bewoording dat de ten minste ene bron "op de proceskamer is gemonteerd" ruim te worden uitgelegd en kan bijvoorbeeld de betekenis bevatten dat de bron bovenop, naast, nabij, onder de proceskamer of anderszins ten opzichte van de proceskamer is gemonteerd, doch ten minste zodanig dat althans een deel van een door die bron gegenereerd plasma een oppervlak van een in de proceskamer opgesteld substraat S kan bereiken.

Verder kan de proceskamer zijn ingericht om één of meer dan één substraat in te plaatsen.

Een te behandelen substraat kan bijvoorbeeld een halfgeleiderwafer, een compact of DVD-disk zoals voor opslag van muziek, video, computergegevens, een zonnecelsubstraat, een displaysubstraat of dergelijke omvatten. Het substraat kan schijfvormig, cirkelvormig, hoekig of anderszins zij uitgevoerd.

Het door PECVD te deponeren materiaal kan verscheidene materialen omvatten, waarvan een opsomming buiten de grenzen van deze tekst liggen, maar een verwijzing naar de elementen van het periodiek systeem en mogelijke atomaire en/of moleculaire combinaties van die elementen geeft een aardige indruk van het geen te deponeren is.

De uitvinding is niet beperkt tot een beweegbare bron maar omvat tevens een vast opgestelde bron met een beweegbare behandelfluïdumtoevoerbron.

De uitvinding omvat ook een van meerdere beweegbare bronnen en/of beweegbare behandelfluïdumtoevoerbronnen voorziene werkwijze en inrichting.

## CONCLUSIES

1. Werkwijze voor het behandelen van een oppervlak van ten minste één substraat, waarbij het ten minste een substraat in een proceskamer wordt geplaatst, waarbij de druk in de proceskamer relatief laag is, waarbij een plasma wordt opgewekt door ten minste één op de proceskamer
- 5 gemonteerde plasmabron, met het kenmerk, dat de althans één plasmabron (3) en/of althans één eventueel voorziene behandelfluïdumtoevoerbron tijdens de behandeling wordt bewogen ten opzichte van het substraatoppervlak.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de
- 10 plasmabron (3) en/of de eventuele behandelfluïdumtoevoerbron om ten minste één rotatieas (14, 15) wordt geroteerd, welke as (14, 15) zich in hoofdzaak evenwijdig aan het substraatoppervlak uitstrekt.
3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de
- 15 plasmabron (3) en/of de eventuele behandelfluïdumtoevoerbron in een naar het substraatoppervlak toe of daarvan afgeweerde richting wordt bewogen.
4. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de plasmabron (3) en/of de eventuele behandelfluïdumtoevoerbron in ten minste één zijwaartse richting wordt bewogen ten opzichte van het substraatoppervlak.
- 20 5. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de plasmabron (3) en/of de eventuele behandelfluïdumtoevoerbron wordt geroteerd om een as die zich haaks uitstrekt ten opzichte van het substraatoppervlak.
6. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, met het
- 25 kenmerk, dat een behandelfluïdum aan het plasma wordt toegevoegd, in het bijzonder ten behoeve van PECVD.

7. Werkwijze volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat de hoeveelheid aan het plasma toe te voegen behandelfluïdum is gerelateerd aan de beweging van de ten minste ene plasmabron (3).
8. Werkwijze volgens conclusie 6 of 7, met het kenmerk, dat de 5 plasmabron een cascadebron (3) is, waarbij een behandelfluïdum in een voorkamer (6) van de cascadebron (3), nabij een zich in die voorkamer (6) bevindende cascadebron-kathode (4), wordt toegevoerd.
9. Werkwijze volgens ten minste conclusie 6 of 7, met het kenmerk, dat tussen de ten minste ene plasmabron (3) en het substraatoppervlak ten 10 minste één behandelfluïdumtoevoerbron (9) is opgesteld om het behandelfluïdum aan het plasma toe te voegen.
10. Werkwijze volgens conclusie 9, met het kenmerk, dat de ten minste ene behandelfluïdumtoevoerbron (9) tijdens de behandeling wordt bewogen ten opzichte van het substraatoppervlak, waarbij de beweging van de 15 behandelfluïdumtoevoerbron (9) gerelateerd is aan de beweging van de ten minste ene plasmabron (3).
11. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de ten minste ene plasmabron (3) zodanig wordt bewogen, dat elk deel van het substraatoppervlak in hoofdzaak dezelfde mate van 20 behandeling ondergaat, in het bijzonder doordat elk deel van dat oppervlak door dezelfde hoeveelheid plasma wordt bereikt.
12. Werkwijze volgens één van de conclusies 1-10, met het kenmerk, dat de ten minste ene plasmabron (3) zodanig wordt bewogen, dat ten minste een eerste deel van het substraatoppervlak in hoofdzaak een grotere 25 mate van behandeling ondergaat dan een tweede deel van dat oppervlak, in het bijzonder doordat het eerste oppervlakdeel door een grotere hoeveelheid plasma wordt bereikt dan het tweede oppervlakdeel.
13. Inrichting voor het behandelen van een oppervlak van ten minste één substraat, waarbij de inrichting is voorzien van een proceskamer en een 30 op die proceskamer gemonteerde plasmabron, met het kenmerk, dat de ten

minste ene plasmabron (3) en/of althans één eventueel voorziene behandelfluidumtoevoerbron beweegbaar is opgesteld.

14. Inrichting volgens conclusie 13, met het kenmerk, dat de plasmabron een cascadebron (3) is, waarbij ten minste één kathode (4) van 5 de cascadebron (3) zich in een voorkamer (6) bevindt waarin tijdens gebruik een relatief hoge druk (P2) heerst ten opzichte van een in de proceskamer (1) heersende druk (P1), waarbij de voorkamer (6) via een relatief nauw kanaal (7) dat wordt begrensd door onderling elektrisch van elkaar geïsoleerde cascadeplaten (8), uitmondt in de proceskamer (1), zodanig dat 10 tijdens gebruik het plasma zich via het relatief nauwe kanaal (7) tot in de proceskamer (1) uitstrekt.

15. Inrichting volgens conclusie 13 of 14, met het kenmerk, dat de inrichting is voorzien van veermiddelen (11) die zijn ingericht om een zodanige veerkracht op de ten minste ene plasmabron (3) uit te oefenen, dat 15 de plasmabron (3) onder invloed van die veerkracht naar een uitgangspositie kan bewegen wanneer de plasmabron (3) zich niet in die uitgangspositie bevindt.

16. Inrichting volgens één van de conclusies 13-15, met het kenmerk, dat tussen de ten minste ene plasmabron (3) en de proceskamer (1) een 20 flexibele, in hoofdzaak gasdichte afdichting is aangebracht.

17. Inrichting volgens één van de conclusies 13-16, met het kenmerk, dat de inrichting is voorzien van een eerste huisdeel (16) en een tweede huisdeel (17), waarbij ten minste ene plasmabron op het eerste huisdeel (16) is aangebracht, waarbij het eerste huisdeel (16, 17) in hoofdzaak gasdicht en 25 beweegbaar aan het tweede huisdeel (17) is gekoppeld, in het bijzonder door een dunwandige RVS-bal (11).

18. Inrichting volgens één van de conclusies 13-17, met het kenmerk, dat de inrichting is voorzien van ten minste één motor (12, 13) ten behoeve van het bewegen van de ten minste ene plasmabron (3).

19. Inrichting volgens één van de conclusies 13-18, met het kenmerk, dat de ten minste ene plasmabron (3) roteerbaar om ten minste een eerste (14) rotatieas en een tweede rotatieas (15) is opgesteld, waarbij de eerste en tweede rotatieas (14 resp. 15) zich elk in hoofdzaak evenwijdig aan het substraatoppervlak en in een verschillende richting uitstrekken.

5 20. Inrichting volgens één van de conclusies 13-19, met het kenmerk, dat de proceskamer (1) is voorzien van ten minste één behandelfluïdumtoevoerbron (9) om een behandelfluïdum aan het plasma toe te voegen, in het bijzonder ten behoeve van PECVD.

10 21. Inrichting volgens ten minste conclusie 14 en 20, met het kenmerk, dat de ten minste ene behandelfluïdumtoevoerbron (9) is ingericht om behandelfluïdum aan het zich via elk relatief nauwe cascadebronkanaal (7) tot in de proceskamer (1) uitstrekende plasma toe te voegen.

22. Inrichting volgens conclusie 21, met het kenmerk, dat de ten minste ene behandelfluïdumtoevoerbron (9) is voorzien van ten minste één plasmadoorgang waardoorheen het plasma zich tijdens gebruik uitstrekkt.

15 23. Inrichting volgens één van de conclusies 20-22, met het kenmerk, dat de ten minste ene behandelfluïdumtoevoerbron (9) beweegbaar in de proceskamer (1) is opgesteld.

20 24. Inrichting volgens conclusie 23, met het kenmerk, dat de ten minste ene behandelfluïdumtoevoerbron (9) aan de ten minste ene plasmabron is gekoppeld, zodanig dat de beweging van de ten minste ene behandelfluïdumtoevoerbron (9) gerelateerd is aan de beweging van de ten minste ene plasmabron (3).

25 25. Substraat, voorzien van een oppervlak met ten minste één daarop door middel van PECVD gedeponeerde laag materiaal, met het kenmerk, dat de laag is gedeponeerd met een werkwijze volgens één van de conclusies 1-12 en/of onder gebruikmaking van een inrichting volgens één van de conclusies 13-24.

1022155

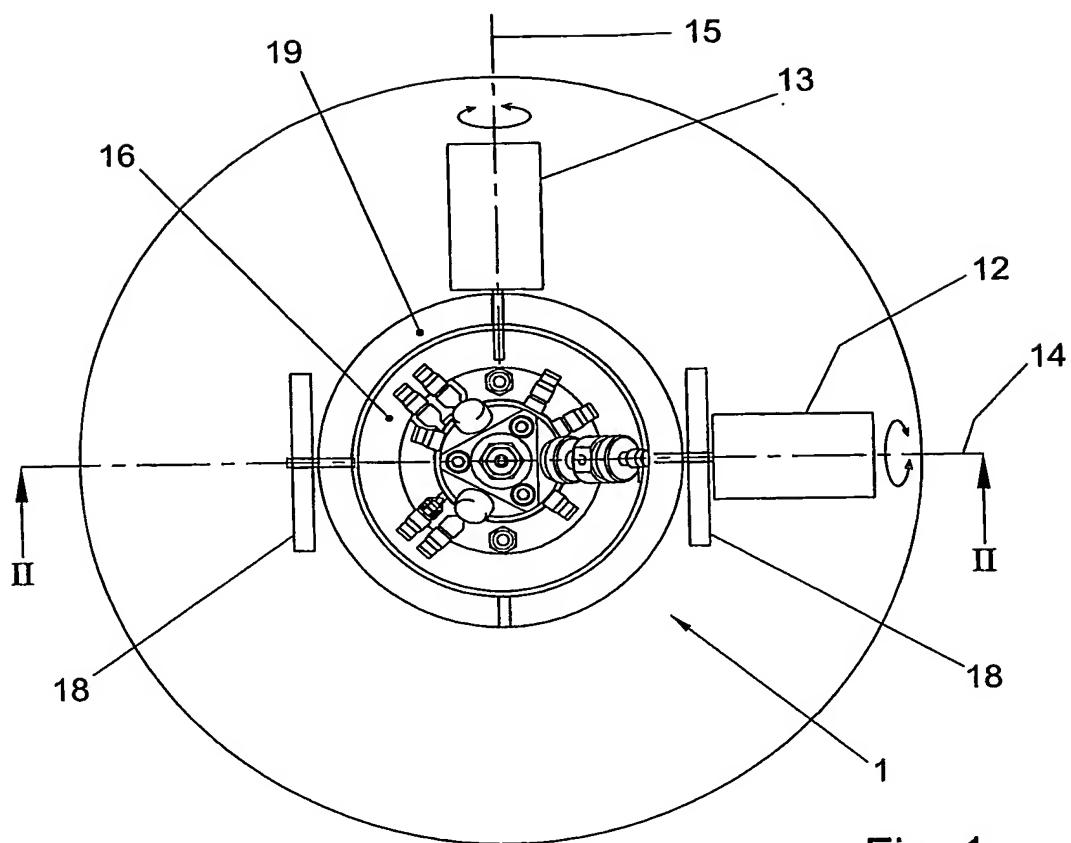


Fig. 1

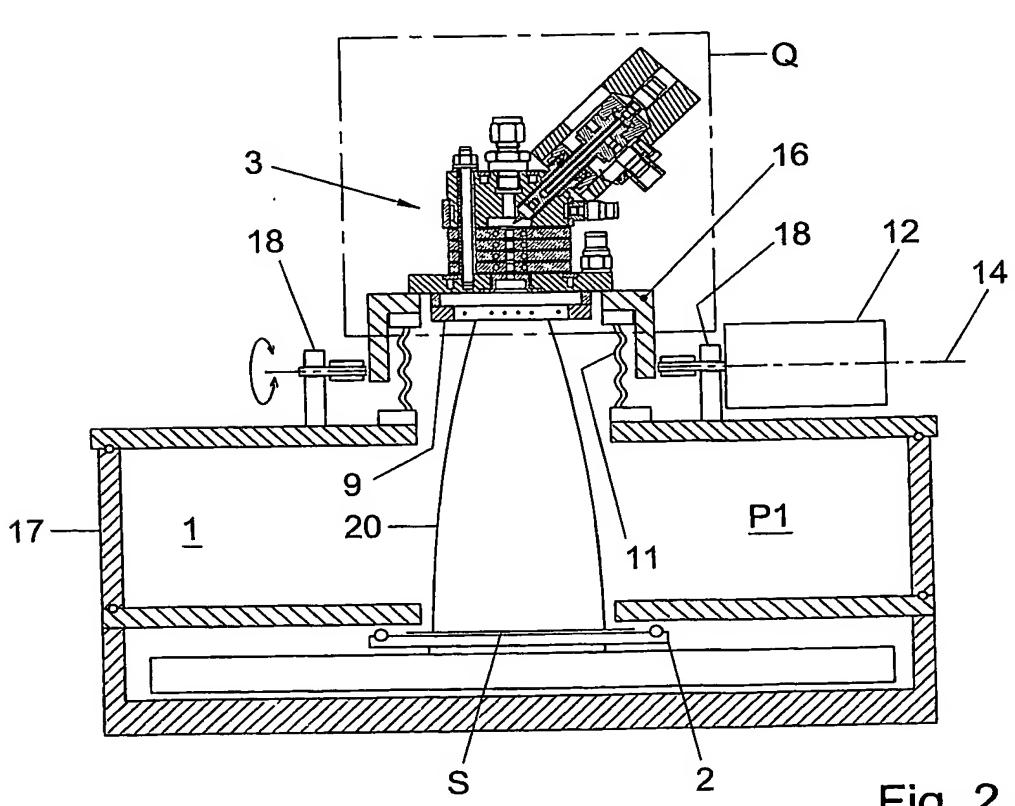


Fig. 2

1922155

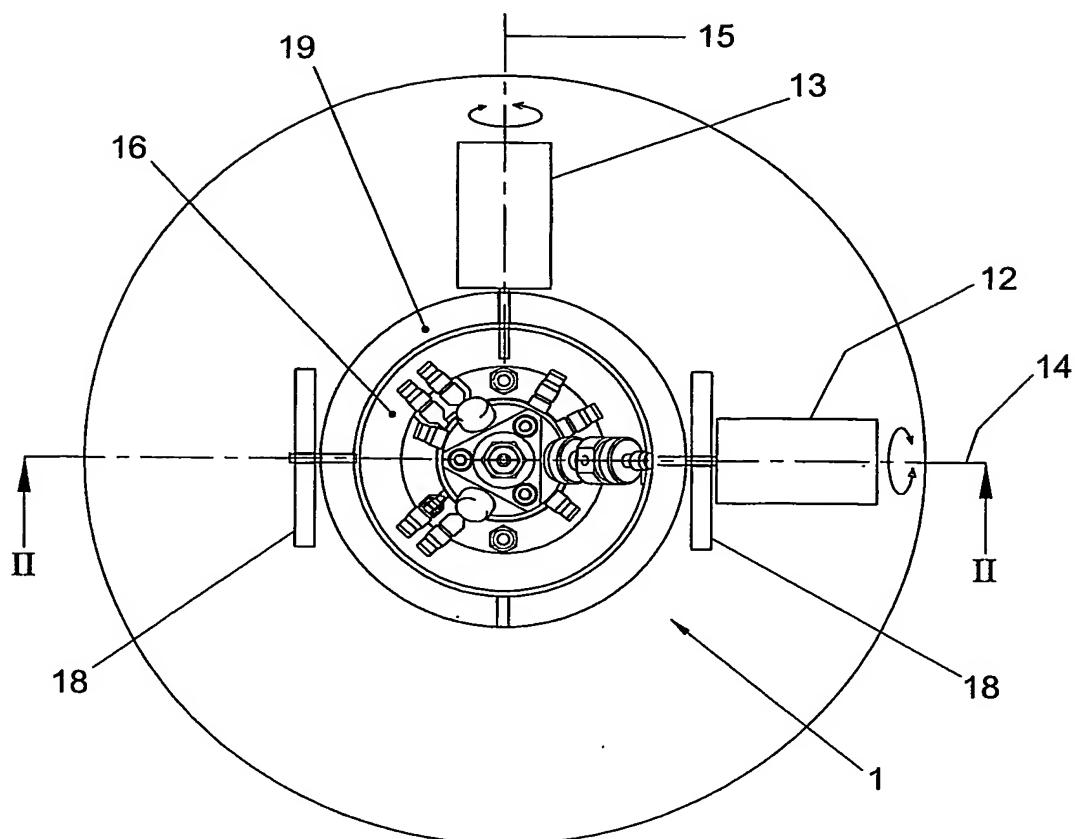


Fig. 1

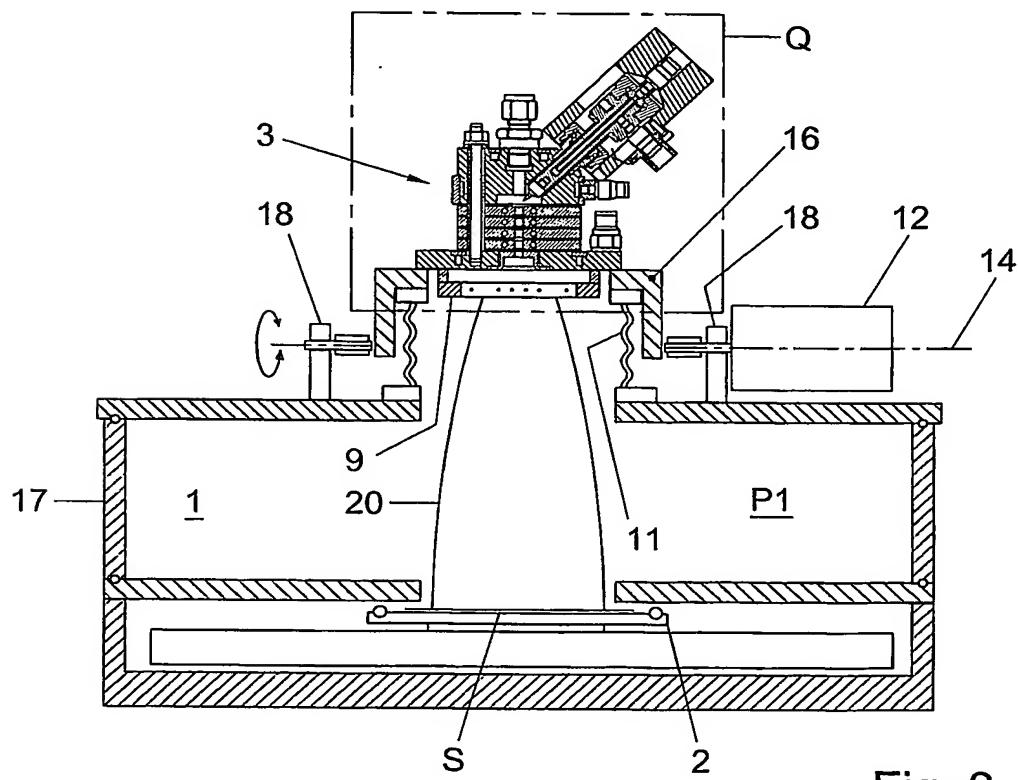
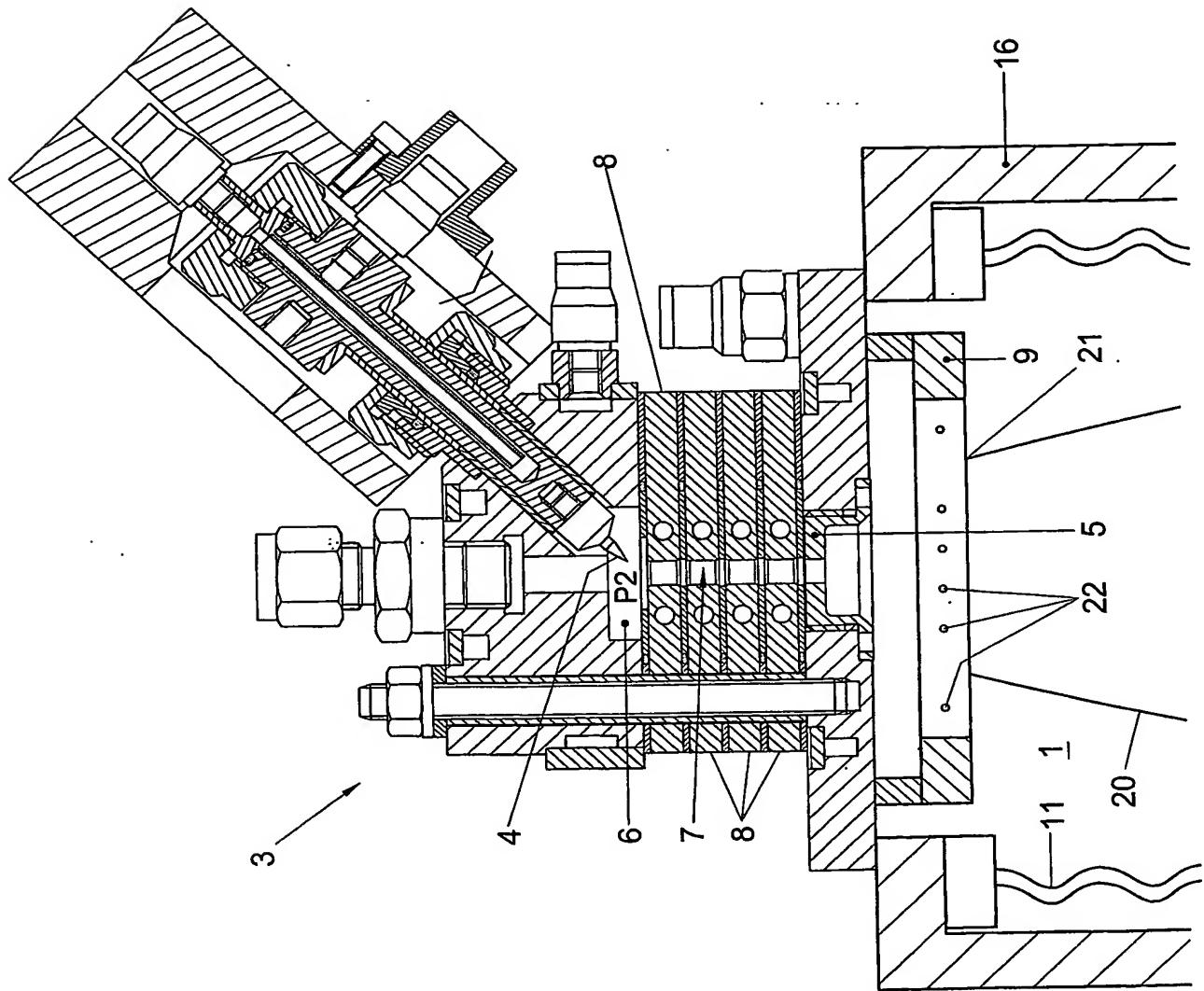


Fig. 2

1022155

Fig. 3



11.91 b

1082155

